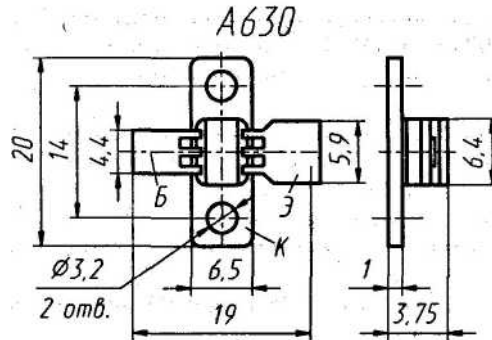


## А630

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* генераторный. Предназначен для применения в усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах в непрерывном и импульсном режимах в диапазоне частот 0,4...1,5 ГГц в схеме с общей базой при напряжении питания 28В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Допускается наносить условную маркировочную точку красного цвета, тогда тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 2 г.

Изготовитель — завод «Пульсар» г. Москва.



### Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 1$ ГГц при $U_{KB} = 28$ В, $P_{вх} = 6,5$ Вт, медианное значение, не менее	30 В
Коэффициент полезного действия коллектора на $f = 1$ ГГц при $U_{кб} = 28$ В, $P_{вх} = 6,5$ Вт, медианное значение, не менее	55%
Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме ОБ на высокой частоте при $U_{кб} = 10$ В, $I_{к} = 0,1$ А, $f = 100$ МГц, не более	$10 \cdot 10^3$
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кб} = 10$ В, $I_{к} = I_{к1}^1$ , $f = 300$ МГц, не менее	2,4
Критический ток при $U_{кб} = 10$ В, $f = 300$ МГц, не менее	6 А
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более	50 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 50$ В, не более	50 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 3,5$ В, не более	10 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база <sup>2</sup> при $T_{к} = +25...+125$ °С	50 В
Постоянное напряжение эмиттер—база.....	3,5 В
Потенциал статического электричества.....	1000 В
Постоянный ток коллектора .....	2,5 А
Импульсный ток коллектора при $C_{и} = 10$ мкс, $Q = 20$	5 А
Постоянный ток базы.....	1 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора <sup>3</sup> в динамическом режиме при $T_{к} = -60...+25$ °С	37,5 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода.....	+175 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус.....	4 °С/Вт
Температура окружающей среды.....	-60... $T_{к} = +125$ °С

<sup>1</sup>  $I_{к1}$  — ток коллектора, при котором  $|h_{21Э}|$  имеет максимальное значение.

<sup>2</sup> При понижении температуры корпуса от +25 до -60 °С  $U_{кб\text{ макс}}$  снижается линейно до 45 В.

<sup>3</sup> При  $T_{к} > +25$  °С максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме рассчитывается по формуле

$$P_{к\text{ ср макс}} = (175 - T_{к})/4, \text{ Вт.}$$

При работе транзистора в импульсном режиме напряжение питания коллектора не должно превышать 40 В,  $t_{и}=20\text{мкс}$ ;  $Q = 10$ , в непрерывном режиме — 28 В. При этом параметр транзистора на частотах выше 1 ГГц не нормируются. В статическом режиме допускается ток эмиттера до 30 мА при напряжении источника питания до 28В во всем диапазоне температур. Применение транзистора в других статических режимах, том числе в режиме класса «А», не допускается.

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 3 мм. Температура пайки  $+250 \pm 10^{\circ}\text{C}$ . Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм, при этом температура пайки не должна превышать  $+150^{\circ}\text{C}$ . Время пайки не более 3 с. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода 3 мм. Допускается обрезка выводов на расстоянии 1 мм от корпуса.